

Semiconductor light emitting module

Publication number: DE19901916

Publication date: 1999-08-05

Inventor: TODA HIDEKAZU (JP); ISOKAWA SHINJI (JP)

Applicant: ROHM CO LTD (JP)

Classification:


- international: **H01L33/00; H01L33/00**; (IPC1-7): H01L31/00

- European: H01L33/00B2B; H01L33/00B2D; H01L33/00B6C2

Application number: DE19991001916 19990119

Priority number(s): JP19980055662 19980129; JP19980055661 19980130

Also published as:

 US6184544 (B

[Report a data error here](#)

Abstract of **DE19901916**

The module (20) has a laminated first reflecting substrate (21) and a second reflecting substrate (22), which contains a cavity (22a). The cavity holds a semiconductor LED element (6) embossed on the first substrate at the side away from the light emitting side, on which are formed p- or n-conductive electrode: The LED element is sealed by a transparent region (8) of synthetic resin. The LED element is embossed on a wiring on the face of the first substrate, facing the cavity in the second substrate such that the electrodes are coupled to bushing conductors (23,24) of the first substrate.

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide



①⑨ **BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND**



**DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT**

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 199 01 916 A 1**

⑤① Int. Cl.⁶:
H 01 L 31/00

②① Aktenzeichen: 199 01 916.9
②② Anmeldetag: 19. 1. 99
④③ Offenlegungstag: 5. 8. 99

DE 199 01 916 A 1

③⑩ Unionspriorität:

10-055662 29. 01. 98 JP
10-055661 30. 01. 98 JP

⑦① Anmelder:

Rohm Co. Ltd., Kyoto, JP

⑦④ Vertreter:

BOEHMERT & BOEHMERT, 28209 Bremen

⑦② Erfinder:

Toda, Hidekazu, Kyoto, JP; Isokawa, Shinji, Kyoto, JP

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

⑤④ Halbleitende lichtemittierende Vorrichtung

⑤⑦ Die Erfindung betrifft eine halbleitende lichtemittierende Vorrichtung, mit einem ersten reflektierenden Substrat; einem zweiten reflektierenden Substrat, das eine Kavität aufweist und auf das erste reflektierende Substrat auflaminiert ist; einem halbleitenden lichtemittierenden Element, das in der Kavität des zweiten reflektierenden Substrats beherbergt ist und auf das erste reflektierende Substrat auf der von der lichtemittierenden Seite abgewandten Seite aufgeprägt ist, auf der Elektroden der p-leitenden bzw. n-leitenden Seite ausgebildet sind.
Die erfindungsgemäße halbleitende lichtemittierende Vorrichtung weist somit eine erhöhte Lichtemissionseffizienz auf und kann flach ausgestaltet werden.

DE 199 01 916 A 1

Die vorliegende Erfindung betrifft eine halbleitende lichtemittierende Vorrichtung.

Eine halbleitende lichtemittierende Vorrichtung von dem Typ, der auf einer Oberfläche aufgebracht ist und bei dem lichtemittierende Elemente eingesetzt werden, sind in verschiedenen Industrie- und Verbraucher-Vorrichtungen verwendet worden. Eine solche Vorrichtung ist beispielsweise in der japanischen Offenlegungsschrift Nr. 9-283803 offenbart. Ein weiteres Beispiel für solch eine bekannte halbleitende lichtemittierende Vorrichtung wird im Anschluß mit Bezug auf Fig. 1 beschrieben.

Fig. 1 zeigt eine Schnittansicht, die eine halbleitende lichtemittierende Vorrichtung 11 darstellt, die ein lichtemittierendes Diodenelement, im Anschluß als LED-Element 6 bezeichnet, als ein halbleitendes lichtemittierendes Element enthält. Die Vorrichtung 11 umfaßt ein rechteckiges, nicht-leitendes Substrat 1, das aus einem elektrisch isolierenden Material, wie Keramiken oder einem nicht-transparenten synthetischen Harz, ausgebildet ist und das mit einem Paar metallisierter Leitungsschichten 2, 3 beschichtet ist, die von der Unterseite des rechteckigen, nichtleitenden Substrats 1 zu der Oberseite desselben über dessen Längsseiten verläuft. Das LED-Element 6 ist mit einer lichtemittierenden Schicht aus einer Nitridverbindung, wie GaN, die auf ein Saphir-Substrat 6a aus der Dampfphase gezüchtet ist, und mit einer Elektrode auf der p-leitenden Seite sowie einer Elektrode auf der n-leitenden Seite auf der Seite, die dem rechteckigen, nicht-leitenden Substrat 1 zugewandt ist, ausgebildet.

Ferner ist ein Reflektor 7 vorgesehen, der mit einer Kavität 7a zum Aufnehmen des LED-Elements 6 ausgebildet ist. Der Reflektor 7 ist aus einem Substrat aus einem nichttransparenten synthetischen Harz in einer bestimmten Dicke ausgeformt. Die Kavität 7a ist auf ihren Längsseiten mit einer reflektierenden Beschichtung zum Bilden einer Reflektionsschicht versehen. Der Reflektor 7 ist auf das rechteckige, nicht-leitende Substrat 1 über Verbindungsschichten 9, 10 auflaminiert.

Ein elektrisch leitendes Material 4 bzw. 5 ist auf der dem LED-Element 6 zugewandten Fläche jeder metallisierten Leitungsschicht 2 bzw. 3 aufgebracht. Das LED-Element 6 ist auf das rechteckige, nicht-leitende Substrat 1 unter Verwendung der elektrisch leitenden Materialien 4, 5 als Bindematerial aufgeprägt, so daß das LED-Element 6 innerhalb der Kavität 7a des Reflektors 7 beherbergt ist, und die Elektroden der p-leitenden sowie n-leitenden Seite auf dem Substrat 6a des LED-Elements 6 sind elektrisch mit dem Paar metallisierter Leitungsschichten 2, 3 verbunden. Ein aus einem transparenten oder halbdtransparenten synthetischen Harz ausgeformter Bereich 8 stellt einen lichttransmittierbaren, aus synthetischem Harz ausgeformten Bereich dar, der die komplette Oberfläche des LED-Elements 6 zum Abdichten desselben bedeckt.

Die so ausgebildete halbleitende lichtemittierende Vorrichtung 11, die das LED-Element 6 umfaßt, das auf das rechteckige nicht-leitende Substrat 1 aufgeprägt ist, ist mit einer Oberfläche auf eine Leiterplatte aufgebracht. Die metallisierten Leitungsschichten 2, 3, die aus einem elektrisch leitenden Material hergestellt sind, sind dabei mit Leitungen auf der Leiterplatte verbunden.

Das Ausgabelicht, das von der beschichteten Oberfläche 6b des Saphir-Substrats 6a des halbleitenden LED-Elements 6 emittiert wird, wird durch den ausgeformten Bereich 8 transmittiert und dann nach außen emittiert. Ein Teil des Ausgabelichtes wird an der Seite der Kavität 7a des Reflektors 7 reflektiert. Das reflektierte Licht wird auch durch den ausgeformten Bereich 8 transmittiert und nach außen emittiert,

so daß die Lichtemissionseffizienz der halbleitenden, lichtemittierenden Vorrichtung 11 erhöht ist.

Da das reflektierende Beschichtungsmaterial auf die Seitenwand der Kavität 7a aufgebracht werden muß, die aus dem Substrat aus nicht-transparentem synthetischem Harz ausgebildet wird, um die Lichtemissionseffizienz der bekannten halbleitenden lichtemittierenden Vorrichtung zu verbessern, besteht ein Problem dadurch, daß die Arbeitszeit und somit auch die Herstellungskosten erhöht werden. Das Ausgabelicht, das in eine Richtung emittiert wird, die der lichtemittierenden Fläche der halbleitenden lichtemittierenden Vorrichtung gegenüberliegt, geht in erheblichem Umfang verloren, so daß es nicht effektiv genutzt wird.

Da der Reflektor 7 als ein getrenntes Element in einer vorherbestimmten Dicke ausgebildet ist und auf das nicht-leitende Substrat 1 auflaminiert wird, kann die Dicke des Reflektors 7 größer als die notwendige Dicke sein, selbst wenn die Dicke des halbleitenden LED-Elements 6 dünner gemacht ist. Dies führt dazu, daß die halbleitende lichtemittierende Vorrichtung insgesamt eine große Höhe T_1 senkrecht zur Schichtenfolge aufweist.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine halbleitende lichtemittierende Vorrichtung zu liefern, die die Nachteile des Stands der Technik überwindet, insbesondere kostengünstig herstellbar ist, eine verbesserte Lichtemissionseffizienz aufweist und in dünner Form herstellbar ist, so daß Höhe und Gewicht reduziert sind. Dabei soll vorzugsweise ein LED-Element mit einer hohen Lichtemissionseffizienz verwendbar sein, wie in der ebenfalls anhängigen japanischen Patentanmeldung Nr. 10-55662 beschrieben.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine halbleitende lichtemittierende Vorrichtung gelöst, mit einem ersten reflektierenden Substrat; einem zweiten reflektierenden Substrat, das eine Kavität aufweist und auf das erste reflektierende Substrat auflaminiert ist; einem halbleitenden lichtemittierenden Element, das in der Kavität des zweiten reflektierenden Substrats beherbergt ist und auf das erste reflektierende Substrat auf der von der lichtemittierenden Seite abgewandten Seite aufgeprägt ist, auf der Elektroden der p-leitenden bzw. n-leitenden Seite ausgebildet sind; und einem lichttransmittierbaren, aus synthetischem Harz ausgeformten Bereich zum Abdichten des halbleitenden lichtemittierenden Elements.

Dabei kann erfindungsgemäß vorgesehen sein, daß das halbleitende lichtemittierende Element auf eine Verkabelung auf der Fläche des ersten reflektierenden Substrats aufgeprägt ist, die der Kavität des zweiten reflektierenden Substrats zugewandt ist, so daß die Elektroden auf der von der lichtemittierenden Fläche des halbleitenden lichtemittierenden Elements abgewandten Seite elektrisch mit Durchgangslochleitern auf dem ersten reflektierenden Substrat verbunden sind.

Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, daß das halbleitende lichtemittierende Element folgendes umfaßt: ein Saphir-Substrat, eine Schicht aus einer auf GaN basierenden halbleitenden Verbindung, die eine lichtemittierende Schicht, die auf das Saphir-Substrat auflaminiert ist, enthält und einen Stromdiffusionsfilm, der auf die halbleitende Schicht auflaminiert und aus einem elektrisch leitenden Metallfilm mit einem hohen Lichtreflektionsfaktor ausgebildet ist, wobei das halbleitende lichtemittierende Element auf das erste reflektierende Substrat aufgebracht ist, so daß das Ausgabelicht E der lichtemittierenden Schicht von dem Saphir-Substrat zusammen mit Reflektionslicht R, das von der Stromdiffusionsschicht reflektiert wird, emittiert wird.

Ferner kann gemäß der Erfindung vorgesehen sein, daß

das erste und zweite reflektierende Substrat jeweils ein weißes Substrat ist.

Somit ist erfindungsgemäß ein LED-Element auf eine Leiterplatte auf der Oberfläche eines ersten weißen Substrats, das einer Kavität eines zweiten weißen Substrats gegenüberliegt, unter Verwendung elektrisch leitender Materialien als Verbindungsmaterial aufgebracht, so daß das LED-Element in der Kavität des zweiten weißen Substrats beherbergt ist und Elektroden auf der p-leitenden Seite bzw. n-leitenden Seite auf der der lichtemittierenden Oberfläche eines beschichteten Saphir-Substrats des LED-Elements gegenüberliegenden Seite elektrisch mit Durchgangslochleitern verbunden ist. Das LED-Element, das auf das erste weiße Substrat aufgebracht ist, wird entlang seines Umfangs von einem lichttransmittierbaren aus synthetischem Harz ausgeformten Bereich bedeckt und abgedichtet. Die halbleitende lichtemittierende Vorrichtung weist daher eine erhöhte Lichtemissionseffizienz und eine flache Form auf.

Da das zweite weiße, reflektierende, Substrat, das mit der Kavität ausgebildet ist, auf das erste weiße Substrat laminiert ist und das halbleitende lichtemittierende Element in der Kavität des zweiten weißen Substrats in Übereinstimmung mit der vorliegenden Erfindung beherbergt ist, wird das von dem halbleitenden lichtemittierenden Element emittierte Ausgabelicht auch auf beiden Längsseiten des halbleitenden lichtemittierenden Elements und seiner der lichtemittierenden Fläche gegenüberliegenden Unterseite reflektiert und dann nach außen emittiert. Die Lichtemissionseffizienz der halbleitenden lichtemittierenden Vorrichtung ist daher gegenüber dem Stand der Technik verbessert.

Da das erste und zweite weiße Substrat selbst als reflektierende Schichten für das Ausgabelicht, das von dem halbleitenden lichtemittierenden Element emittiert wird, verwendet wird, ist die Notwendigkeit zum Ausbilden einer zusätzlichen reflektierenden Schicht eliminiert, so daß die Herstellungskosten im Vergleich zum Stand der Technik reduziert sind. Die halbleitende lichtemittierende Vorrichtung kann ferner in flacher Form durch Auswählen der Dicke des zweiten weißen Substrats in Abhängigkeit von der Dicke bzw. Höhe der halbleitenden lichtemittierenden Vorrichtung ausgebildet werden, so daß eine Reduktion in Höhe und Gewicht der Vorrichtung im Vergleich zum Stand der Technik erreicht wird.

Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung, in der ein Ausführungsbeispiel der Erfindung anhand von schematischen Zeichnungen im einzelnen erläutert ist. Dabei zeigt:

Fig. 1 eine Schnittansicht einer bekannten halbleitenden lichtemittierenden Vorrichtung;

Fig. 2 eine Schnittansicht einer erfindungsgemäßen Ausführungsform einer halbleitenden lichtemittierenden Vorrichtung; und

Fig. 3 eine Vorderansicht, im Teillängsschnitt, eines LED-Elements, das beispielsweise in der halbleitenden lichtemittierenden Vorrichtung der vorliegenden Erfindung verwendbar ist.

Im Anschluß wird eine Ausführungsform der Erfindung mit Bezug auf **Fig. 2** beschrieben. **Fig. 2** zeigt dabei eine Schnittansicht einer erfindungsgemäßen halbleitenden lichtemittierenden Vorrichtung **20**. Diejenigen Bauteile, die im wesentlichen den Bauteilen entsprechen, die mit Bezug auf **Fig. 1** für die bekannte Vorrichtung beschrieben worden sind, weisen gleiche Bezugszeichen auf und werden im Anschluß nicht weiter beschrieben. Die halbleitende lichtemittierende Vorrichtung **20** kann ein LED-Element **6** verwenden, das den gleichen Aufbau aufweist wie mit Bezug auf **Fig. 1** beschrieben.

Gemäß **Fig. 2** hat ein erstes weißes Substrat **21** auf einer

Fläche eine bestimmte Verkabelung und Durchgangslochleiter **23, 24**, die sich durch Durchgangslöcher bis zu besagter Fläche erstrecken. Das erste weiße Substrat **21** ist aus einem synthetischen Harzsubstrat hergestellt. Ein zweites weißes Substrat **22**, das mit einer Kavität **22a** ausgebildet ist, ist aus dem gleichen synthetischen Harzmaterial wie das erste Substrat **21** ausgebildet. Das zweite weiße Substrat **22** ist auf das erste weiße Substrat **21** durch Verbinden mittels Verbindungsmaterial **9, 10** aufgebracht. Die Dicke des zweiten weißen Substrats **22** wird unter Berücksichtigung der mechanischen Stärke und dergleichen, abhängig von der Dicke des halbleitenden lichtemittierenden Elements **6** bestimmt. Demgemäß kann die Höhe T_2 der halbleitenden lichtemittierenden Vorrichtung **20** senkrecht zur Schichtfolge herabgesetzt werden.

Das LED-Element **6** ist auf die Verkabelung auf der einen Fläche des ersten weißen Substrats **21**, die der Kavität **22a** des zweiten weißen Substrats **22** zugewandt ist, unter Einsatz elektrisch leitenden Materials **4, 5**, wie Verbindungsmaterial, aufgebracht, so daß das LED-Element **6** in der Kavität **22a** des zweiten weißen Substrats **22** beherbergt ist und Elektroden der p-leitenden sowie n-leitenden Seite des LED-Elements **6** auf der Seite, die von der lichtemittierenden Oberfläche eines Saphir-Substrats **6b** des LED-Elements **6** abgewandt ist, elektrisch mit den Durchgangslochleitern **23, 24** verbunden. Das LED-Element **6**, das auf das erste weiße Substrat **21** aufgebracht ist, ist entlang seines kompletten Umfangs mittels eines lichttransmittierbaren, aus synthetischem Harz ausgeformten Bereichs **8** bedeckt und abgedichtet.

Das Ausgabelicht, das von der einen Oberfläche **6b** des Saphir-Substrats des LED-Elements **6** emittiert wird, wird durch den ausgeformten Bereich **8** transmittiert und dann nach außen emittiert. Ein Teil des Ausgabelichts wird an den Längsseiten des zweiten weißen Substrats **22** reflektiert. Das Ausgabelicht, das in Richtung der anderen Oberfläche **6a** emittiert wird, an der die Elektroden der p-leitenden sowie n-leitenden Seite auf der von der lichtemittierenden Fläche des LED-Elements **6** abgewandten Seite bereitgestellt sind, wird auch von dem ersten weißen Substrat **21** reflektiert.

Mit anderen Worten wird das Ausgabelicht, das von dem LED-Element **6** emittiert wird, sowohl von der Rückseite als auch der Längsseite des LED-Elements **6** durch das erste bzw. zweite weiße Substrat **21, 22** reflektiert. Das reflektierte Licht, das von dem ersten bzw. zweiten weißen Substrat **21, 22** reflektiert wird, wird durch den ausgeformten Bereich **8** transmittiert und dann nach außen emittiert. Demgemäß kann die Lichtemissionseffizienz verbessert werden, da das Ausgabelicht, das in eine Richtung emittiert wird, die der lichtemittierenden Fläche **6b** des LED-Elements **6** gegenüberliegt, effektiv benutzt wird, indem es nach außen als reflektiertes Licht emittiert wird.

Die halbleitende lichtemittierende Vorrichtung **20** weist keinen Reflektor auf, der aus einem zusätzlichen Glied hergestellt ist und in einer vorherbestimmten Decke ausgeformt ist. Im Gegensatz zum Stand der Technik, und die Dicke des zweiten weißen Substrats **22** kann ausgewählt werden in Abhängigkeit von der Dicke des LED-Elements **6**, so daß die Höhe T_2 senkrecht zur Schichtenfolge im Vergleich zum Stand der Technik reduziert werden kann. Obwohl die Höhe T_1 der bekannten halbleitenden lichtemittierenden Vorrichtung **11** in der Größenordnung von ungefähr 0,5 mm liegt, kann die Höhe T_2 der erfindungsgemäßen halbleitenden lichtemittierenden Vorrichtung **20** auf 0,3 mm oder weniger reduziert werden. Demgemäß hat die erfindungsgemäße halbleitende lichtemittierende Vorrichtung **20** den Vorteil, daß sie für tragbare Produkte verwendbar ist, die eine Reduktion in Größe und Gewicht der Vorrichtung fordern.

Fig. 3 zeigt ein Beispiel für das LED-Element **6**, das mit der erfindungsgemäßen halbleitenden lichtemittierenden Vorrichtung verwendbar ist und im wesentlichen dem in der ebenfalls anhängigen japanischen Patentanmeldung Nr. 10-55662 offenbarten LED-Element entspricht. Demgemäß ist eine Tieftemperatur-Pufferschicht **12** aus GaN auf einem Saphir-Substrat **6b** ausgebildet, und eine n-leitende Schicht **13** ist auf der Tieftemperatur-Pufferschicht **12** ausgebildet. Eine aktive Schicht **14** aus einer auf InGaN basierenden halbleitenden Verbindung dient als eine lichtemittierende Schicht, auf der wiederum eine p-leitende Schicht **15** aufgebracht ist. Die n-leitende Schicht **13**, die aktive Schicht **14**, die als lichtemittierende Schicht dient, und die p-leitende Schicht **15**, die aus einer auf GaN basierenden halbleitenden Verbindung hergestellt ist, sind aufeinanderfolgend auf dem Saphir-Substrat **6b** aufgebracht. Zudem ist ein Stromdiffusionsfilm **16** vorgesehen, der aus einem elektrisch leitenden Material mit einem hohen Lichtreflektionsfaktor auf der p-leitenden Schicht **15** ausgebildet ist. Das Metall des Stromdiffusionsfilms **16** kann Al, Ni, Ti oder Pt enthalten und ist eben auf der p-leitenden Überzugsschicht **15** ausgebildet. Das LED-Element **6** ist auf eine Leiterplatte derart aufgebracht, daß das Ausgabelicht der lichtemittierenden Schicht **4** von dem Saphir-Substrat **6b** als Emissionsschicht **E** direkt emittiert wird. Das reflektierte Licht **R**, das von dem Stromdiffusionsfilm **16** reflektiert wird, wird ebenfalls von dem Saphir-Substrat **6b** emittiert.

Das LED-Element **6** ist auf dem ersten weißen Substrat **21** aufgebracht, so daß das Ausgabelicht von der lichtemittierenden Schicht **14** auf der Seite, die dem Saphir-Substrat **6b** zugewandt ist, emittiert wird. Beim Aufbringen des LED-Elements **6** auf das erste weiße Substrat **21** wird eine Seite **6a** des LED-Elements **6**, auf der die Elektroden **17**, **18** der n-leitenden bzw. der p-leitenden Seite ausgebildet sind, auf die Leiterplatte oder das mit metallisiertem Draht versehene erste weiße Substrat **21** unter Verwendung eines elektrisch leitenden Materials als Bindematerial aufgeprägt. Durch Aufbringen des LED-Elements **6** auf das erste weiße Substrat **21** wird ein primäres Licht **E**, das direkt von dem LED-Element **6** über das Saphir-Substrat **6b** emittiert wird, durch ein reflektiertes Licht **R**, das von dem Stromdiffusionsfilm **16** reflektiert wird, verstärkt, so daß das resultierende Licht von dem Saphir-Substrat **6b** emittiert wird. Bei einem Typ eines LED-Elements **6** ist der Stromdiffusionsfilm **16** auf der p-leitenden Überzugsschicht **15** zum Beliefern der lichtemittierenden Schicht **14** mit einem uniformen Strom ausgebildet. Bei dem LED-Element **6**, das in der erfindungsgemäßen halbleitenden lichtemittierenden Vorrichtung **20** verwendet wird, wird ein Metall mit einem hohen Lichtreflektionsfaktor verwendet, so daß der Stromdiffusionsfilm **16** als ein Reflektor des Ausgabelichts von der lichtemittierenden Schicht **14** fungiert. Daher kann der Stromdiffusionsfilm **16**, der ansonsten das Ausgabelicht, das von den bekannten LED-Elementen emittiert wird, reduziert, auf vorteilhafte Weise als ein Mittel zum Erhöhen des von dem LED-Element emittierten Ausgabelichts verwendet werden.

Da das LED-Element **6** auf dem ersten weißen Substrat **21** derart aufgebracht ist, daß das Ausgabelicht von der lichtemittierenden Schicht **14** von dem Stromdiffusionsfilm **16** reflektiert wird und dann von der Saphir-Substratoberfläche **6b** in Übereinstimmung mit der gegenwärtigen Erfindung emittiert wird, kann der Stromdiffusionsfilm **16**, der ansonsten die Menge an Ausgabelicht der lichtemittierenden Schicht **14** herabsetzt, vorteilhafterweise als Mittel zum Erhöhen der Menge an Ausgabelicht verwendet werden. Die Lichtemissionseffizienz des LED-Elements **6** ist daher gegenüber dem Stand der Technik verbessert. Demgemäß er-

möglicht die Verwendung solcher LED-Elements **6**, die Lichtemissionseffizienz der halbleitenden lichtemittierenden Vorrichtung **20** weiter zu verbessern.

In der oben beschriebenen Ausführungsform der halbleitenden lichtemittierenden Vorrichtung **20** ist das LED-Element **6** beschrieben worden, bei dem die lichtemittierende Schicht aus einer auf GaN basierenden halbleitenden Verbindung aus der Dampfphase gezüchtet auf das Substrat **6b** aufgebracht ist, das aus einem lichttransmittierbaren isolierenden Material ausgebildet ist, das eine hohe Härte aufweist, wie Saphir, wobei die Seite der lichtemittierenden Schicht der Substrat-Oberfläche **6b** zugewandt ist, die als lichtemittierende Fläche fungiert.

Das halbleitende lichtemittierende Element, das mit der halbleitenden lichtemittierenden Vorrichtung der gegenwärtigen Erfindung verwendet wird, ist nicht auf das LED-Element beschränkt, das den oben beschriebenen Aufbau hat, jedoch ist im allgemeinen ein halbleitendes lichtemittierendes Element verwendbar, bei dem die Elektroden auf der p-leitenden bzw. n-leitenden Seite auf einer Seite davon ausgebildet sind.

Die in der vorstehenden Beschreibung, in den Zeichnungen sowie in den Ansprüchen offenbarten Merkmale der Erfindung können sowohl einzeln als auch in jeder beliebigen Kombination für die Verwirklichung der Erfindung in ihren verschiedenen Ausführungsformen wesentlich sein.

Bezugszeichenliste

- 1 Nicht-leitendes Substrat
- 2 Metallisierte Leitungsschicht
- 3 Metallisierte Leitungsschicht
- 4 Elektrisch leitendes Material
- 5 Elektrisch leitendes Material
- 6 LED-Element
- 6a Saphir-Substrat-Oberfläche
- 6b Saphir-Substrat-Oberfläche
- 7 Reflektor
- 7a Kavität
- 8 Synthetisches Harz
- 9 Verbindungsschicht
- 10 Verbindungsschicht
- 11 Halbleitende lichtemittierende Vorrichtung
- 12 Tieftemperatur-Pufferschicht
- 13 n-leitende Schicht
- 14 aktive Schicht
- 15 p-leitende Schicht
- 16 Stromdiffusionsfilm
- 17 Elektrode der n-leitenden Seite
- 18 Elektrode der p-leitenden Seite
- 20 Halbleitende lichtemittierende Vorrichtung
- 21 Weißes Substrat
- 22 Weißes Substrat
- 22a Kavität
- 23 Leiter
- 24 Leiter
- T₁ Höhe
- T₂ Höhe
- E Emissionslicht
- R Reflexionslicht

Patentansprüche

- 1. Halbleitende lichtemittierende Vorrichtung (20), mit einem ersten reflektierenden Substrat (21); einem zweiten reflektierenden Substrat (22), das eine Kavität (22a) aufweist und auf das erste reflektierende

Substrat (21) auflaminiert ist;
einem halbleitenden lichtemittierenden Element (6),
das in der Kavität (22a) des zweiten reflektierenden
Substrats (22) beherbergt ist und auf das erste reflektie- 5
rende Substrat (21) auf der von der lichtemittierenden
Seite abgewandten Seite aufgeprägt ist, auf der Elek-
troden (17, 18) der p-leitenden bzw. n-leitenden Seite
ausgebildet sind; und
einem lichttransmittierbaren, aus synthetischem Harz
ausgeformten Bereich (8) zum Abdichten des halblei- 10
tenden lichtemittierenden Elements (6).
2. Halbleitende lichtemittierende Vorrichtung nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das halblei-
tende lichtemittierende Element (6) auf eine Verkabe- 15
lung auf der Fläche des ersten reflektierenden Substrats
(21) aufgeprägt ist, die der Kavität (22a) des zweiten
reflektierenden Substrats (22) zugewandt ist, so daß die
Elektroden (17, 18) auf der von der lichtemittierenden
Fläche des halbleitenden lichtemittierenden Elements
(6) abgewandten Seite elektrisch mit Durchgangsloch- 20
leitern (23, 24) auf dem ersten reflektierenden Substrat
(21) verbunden sind.
3. Halbleitende lichtemittierende Vorrichtung nach
Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das
halbleitende lichtemittierende Element (6) folgendes 25
umfaßt:
ein Saphier-Substrat (6a, 6b),
eine Schicht aus einer auf GaN basierenden halbleiten-
den Verbindung, die eine lichtemittierende Schicht
(14), die auf das Saphier-Substrat (6a, 6b) auflaminiert 30
ist, enthält und
einen Stromdiffusionsfilm (16), der auf die halblei-
tende Schicht (14) auflaminiert und aus einem elek-
trisch leitenden Metallfilm mit einem hohen Lichtre-
fektionsfaktor ausgebildet ist, wobei 35
das halbleitende lichtemittierende Element (6) auf das
erste reflektierende Substrat (21) aufgebracht ist, so
daß das Ausgabelicht E der lichtemittierenden Schicht
(14) von dem Saphier-Substrat (6b) zusammen mit Re-
flexionslicht R, das von der Stromdiffusionsschicht 40
(16) reflektiert wird, emittiert wird.
4. Halbleitende lichtemittierende Vorrichtung nach ei-
nem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das erste und zweite reflektierende Sub-
strat (21, 22) jeweils ein weißes Substrat ist. 45

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

50

55

60

65

FIG.1

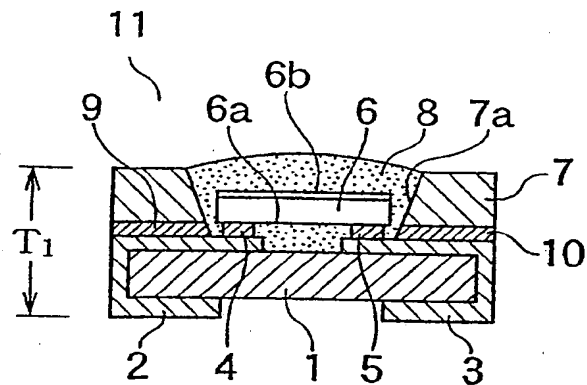


FIG.2

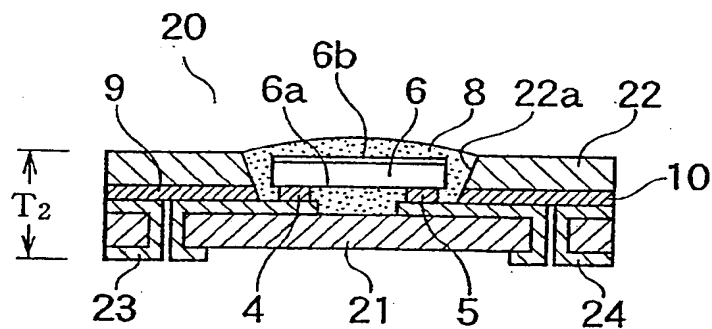


FIG.3

